

## **The Data Book Project**

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

**Scroll down to see the scanned document.**

# FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

**最新トランジスタ規格表** (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )					電 気 的 特 性 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )										外 形	備 考
				$V_{ce0}$ (V)	$V_{be0}$ (V)	$I_c$ (mA)	$P_c$ (mW)	$T_c$ ( $^\circ\text{C}$ )	$I_{c0}$ 最大値 ( $\mu\text{A}$ )	直流又はパルス $h_{FE}$		バイアス		$h_{FE}$	$h_{ie}$ $h_{ie}^*$ ( $\Omega$ )	$h_{re}$ $h_{re}^*$ ( $\times 10^{-4}$ )	$h_{oe}$ $h_{oe}^*$ ( $\mu\text{S}$ )	$f_{\alpha b}$ $f_{\alpha b}^*$ (Mc)		
1	2	3	4	5					6		7		8				9	10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6  $I_{cB0}$  MAXIMUM VALUE AND  $V_{cB}$  VALUE (CRITERIA FOR MEASURING  $I_{cB0}$ )
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE  $h_{FE}$  AND  $V_{cE}$ ,  $I_c$  (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE  $h_{FE}$ )
- 8 STANDARD VALUE OF  $h$  PARAMETERS AND BIAS  $V_{cB}$ ,  $I_E$  (CRITERIA FOR MEASURING  $h$  PARAMETERS)

- \* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
- 9  $f_{\alpha b}$  OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF \* WHICH INDICATES VALUE OF  $f_T$ .
- 10  $C_{ob}$  AND  $r_{bb'}$  OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF \* IN  $r_{bb'}$  COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF  $h_{ie}$  (real)
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO .....

型名	社名	用途	構造	最大定格 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )					電 気 的 特 性 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )										外 形	備 考							
				$V_{CBO}$ (V)	$V_{EBO}$ (V)	$I_C$ (mA)	$P_C$ (mW)	$T_j$ ( $^\circ\text{C}$ )	$I_{CBO}$ 最大値 ( $\mu\text{A}$ )	直流又はパルス $h_{FE}$		バイアス		$h_{fe}$ $h_{fb}^*$	$h_{ie}$ $h_{ib}^*$ ( $\Omega$ )	$h_{re}$ $h_{rb}^*$ ( $\times 10^{-4}$ )	$h_{oe}$ $h_{ob}^*$ ( $\mu\text{S}$ )	$f_{ob}$ $f_T^*$ (Mc)			$C_{ob}$ (pF)	$r_{bb}$ $h_{ie}(\text{real})^*$ ( $\Omega$ )					
										$V_{CE}$ (V)	$I_C$ (mA)	$V_{CB}$ (V)	$I_E$ (mA)														
2SD807	サンケン	SW	Si.TMe	1000	7	5 A	50W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1 mA	1000	11	4	1 A										102				
" 808	日立	RF	Si.EP	25	5	500	400	150	0.2	18	120	1	50	1	-50							250*	3.2	$C_{ob}$ $r_{bb}$ 12pS	138		
" 809	日電	PA.SW	Si.E	100	6	1 A	10W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	0.1	50	250	2	100	2	-10							85*	15		225	2SB731 とコンブリ	
" 810	サンケン	PA	Si.EMe	20	20	4 A	30W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1 mA	20	400	4	1 A												298		
" 811	東芝	PA.SW	Si.TMe	900	5	8 A	50W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1 mA	100	8	5	4 A													102	
" 812	松下	PA	Si.TP	80	5	5 A	50W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	50	80	90	5	1 A													268	
" 813	"	"	Si.EP	25	7	500	200	125	0.1	25	65-220	2	500	10	-50							150*	6		176		
" 814	"	AF.LN	"	150	5	50	200	125	1	100	65-450	5	10	10	-10	$V_{NO} = 150\text{mV}$ (10V, 1mA, $R_G = 100k\Omega$ , $A_1 = 804\text{B}$ )						150*	2.3		176		
" 815																											
" 816	富士電機	SW	Si.TP	300	6	4 A	30W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1 mA	300	1500	2	3 A													268	ターリントン
" 817																											
" 818	東芝	SW	Si.TMe	1500	5	2.5A	50W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	10	500	20	5	500	10	-100	$t_f < 1 \mu\text{S}$						3*	95		102	水平偏向用	
" 819	"	"	"	1500	5	3.5A	50W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	10	500	20	5	500	10	-100	$t_f < 1 \mu\text{S}$						3*	95		102	水平偏向用	
" 820	"	"	"	1500	5	5 A	50W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	10	500	20	5	1 A	10	-100	$t_f < 1 \mu\text{S}$						3*	165		102	水平偏向用	
" 821	"	"	"	1500	5	6 A	50W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	10	500	20	5	1 A	10	-100	$t_f < 1 \mu\text{S}$						3*	165		102	水平偏向用	
" 822	"	"	"	1500	5	7 A	50W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	10	500	20	5	1 A	10	-100	$t_f < 1 \mu\text{S}$						3*	165		102	水平偏向用	
" 823	三洋	SW	Si.EP	200	7	6 A	40W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	100	40	>20	5	3 A	5	-1 A	$t_f < 1 \mu\text{S}$						15*			268		
" 824	日立	PA	Si.T	120	5	6 A	60W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1 mA	80	100	5	1 A													332	
" 825	"	"	"	120	5	7 A	80W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1 mA	100	100	5	1 A													332	
" 826	三洋	SW	Si.EP	60	6	5 A	10W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1	50	120-560	2	500	10	-50								120*	45		296	
" 827	日立	"	Si.T	500	7	4 A	80W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	$I_{CBO}$ 1 mA	500	>500	2	4 A													332	
" 828	"	"	"	500	7	4 A	80W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	5	400	2000	2	4 A													333	ターリントン
" 829	"	"	"	150	7	15A	100W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	0.1	80	4000	2	15A													332	ターリントン
* " 830	富士通	"	Si.P	150	7	5 A	30W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1	100	6000	2	3 A			$t_{on} = 0.2 \mu\text{S}$ , $t_f = 2 \mu\text{S}$ $t_{off} = 7 \mu\text{S}$										268	ターリントン
" 831																											
" 832	富士通	SW	Si.EP	600	6	50A	400W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1 mA	600	200	5	50A			$t_{on} < 1 \mu\text{S}$ , $t_f < 2.5 \mu\text{S}$ $t_{off} < 8 \mu\text{S}$										228	ターリントン
" 833	富士電機	SW.PA	Si.TP	60	5	7 A	40W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	100	60	>4000	3	3 A													268	ターリントン
" 834	"	"	"	250	10	4 A	25W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	100	250	>1500	2	2 A			$t_{on} < 1.7 \mu\text{S}$ , $t_f < 18 \mu\text{S}$ $t_{off} < 15 \mu\text{S}$										268	ターリントン
" 835	"	"	"	400	15	6 A	40W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	100	400	>400	1.5	4 A			$t_{on} < 1 \mu\text{S}$ , $t_f < 6 \mu\text{S}$ $t_{off} < 12 \mu\text{S}$										268	ターリントン
" 836	松下	PA	Si.EP	60	5	2 A	35W ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	150	1 mA	60	1000-10000	4	1 A			$t_{on} = 0.4 \mu\text{S}$ , $t_{off} = 4 \mu\text{S}$										268	ターリントン